



Press release
Communiqué de presse
Comunicato stampa
新闻稿 / 新聞稿
プレスリリース
보도자료

PR N° C3252C

SiCrystal, société du groupe ROHM, et STMicroelectronics étendent leur accord portant sur la fourniture de plaquettes de carbure de silicium

Kyoto (Japon) et Genève (Suisse), le 22 avril 2024 — ROHM (TSE : 6963) et STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annoncent aujourd'hui l'extension de l'accord existant pluriannuel et de long terme portant sur la fourniture de substrats carbure de silicium (SiC) en 150 mm avec SiCrystal, une société du groupe ROHM. Le nouvel accord pluriannuel régit la fourniture de volumes plus importants de substrats SiC fabriqués à Nuremberg (Allemagne) pour une valeur minimale attendue de 230 millions de dollars.

Geoff West, Vice-Président exécutif en charge des achats de STMicroelectronics, a déclaré : *« Cet accord étendu avec SiCrystal nous apportera des volumes supplémentaires de substrats SiC en 150 mm afin de soutenir l'augmentation de notre capacité de fabrication de composants pour nos clients des secteurs de l'automobile et de l'industriel à travers le monde. Il contribue à renforcer la résilience de notre chaîne d'approvisionnement pour notre croissance future avec un mix équilibré entre capacités internes et externes à travers les régions. »*

« SiCrystal, société du groupe ROHM, est l'un des leaders sur le marché du carbure de silicium et fabrique des plaquettes SiC depuis de nombreuses années. Nous sommes très heureux d'étendre cet accord d'approvisionnement avec ST, notre client de longue date. Nous continuerons à soutenir notre partenaire à étendre ses activités dans le domaine du carbure de silicium en augmentant de façon continue les quantités de plaquettes SiC en 150 mm et en fournissant en permanence une qualité fiable », a déclaré le Dr. Robert Eckstein, Président et CEO de SiCrystal, une société du groupe ROHM.

Les semiconducteurs de puissance SiC à haut rendement énergétique permettent l'électrification des secteurs de l'automobile et de l'industriel selon une approche plus durable. En facilitant une production, une distribution et un stockage de l'énergie plus efficaces, le carbure de silicium accompagne la transition vers des solutions de mobilité plus propres, des procédés industriels à plus faibles émissions et un avenir énergétique plus vert, ainsi que des alimentations plus fiables pour des infrastructures gourmandes en ressources telles que les centres de données dédiés aux applications d'intelligence artificielle. Pour de plus amples informations sur les avantages du SiC, visitez le site [st.com/content/st_com/en/about/innovation---technology/SiC.html](https://www.st.com/content/st_com/en/about/innovation---technology/SiC.html).

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l'énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d'ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

À propos de ROHM

Fondée en 1958, la société ROHM fournit des circuits intégrés et des semiconducteurs discrets qui présentent un niveau exceptionnel de qualité et de fiabilité à un large éventail de marchés (automobile, équipements industriels et électronique grand public, notamment) par l'intermédiaire de son réseau mondial de développement et de ventes. Dans le domaine de la puissance analogique, ROHM propose une solution adaptée à chaque application avec des circuits de puissance tels que des circuits de commande et des composants SiC afin de maximiser leurs performances, ainsi que des composants périphériques (transistors, diodes et résistances). Pour de plus amples informations : www.rohm.com

À propos de SiCrystal

SiCrystal, société du groupe ROHM, est l'un des leaders mondiaux sur le marché des plaquettes en carbure de silicium monocristallin. Les substrats semiconducteurs avancés de SiCrystal constituent la base de l'utilisation haute efficacité de l'énergie électrique dans les véhicules électriques, les stations de charge rapide, les énergies renouvelables, ainsi que dans différents domaines d'applications industrielles.

Pour de plus amples informations : www.sicrystal.de

Pour plus d'informations, contacter :

STMicroelectronics

Relations avec les investisseurs :

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

Relations presse :

Nelly Dimey

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

ROHM

Division - Relations Publiques et investisseurs :

Tastuhide Goto

Press@rohm.co.jp

SiCrystal

Division Communication Corporate :

Jennifer Waldmann

pr@sicrystal.de